Communiqué de presse

KIOXIA présentera la technologie XL-FLASH de 3e génération, la mémoire flash de nouvelle génération à faible latence et haute performance pour l'IA, lors du KIOXIA Forum

Le prototype atteint une latence moyenne de lecture de 3 microsecondes



Allemagne, Düsseldorf, le 25 novembre 2026 – KIOXIA Europe GmbH a annoncé aujourd'hui que KIOXIA Corporation présentera un prototype de sa technologie XL-FLASH™ de 3e génération, la nouvelle génération de sa mémoire flash à faible latence et haute performance pour applications d'IA, lors du KIOXIA Forum à Tokyo le 26 novembre 2026.

La technologie XL-FLASH™ offre une latence de lecture nettement plus faible et une endurance d'écriture supérieure à celles des mémoires flash NAND classiques. Elle est en cours de développement pour servir de nouvelle couche mémoire comblant l'écart entre le stockage et la DRAM, en termes de performance, de capacité et de coût.

La mémoire XL-FLASH™ de 3e génération exploite la technologie CBA (CMOS directement lié à la matrice), une caractéristique clé de la mémoire flash 3D KIOXIA BiCS FLASH™, pour offrir une densité de bits environ 70 % supérieure à celle de la mémoire flash XL-FLASH™ de 2e génération, tout en maintenant des performances élevées.

Elle atteint également une latence de lecture moyenne de 3 microsecondes, soit moins d'un dixième des produits TLC KIOXIA BiCS FLASH™ de 8e génération(1). De plus, l'efficacité énergétique pour les lectures dans les unités de 512 octets a été améliorée d'environ 135 % par rapport à la mémoire flash XL-FLASH™ de 2e génération(2). L'envoi d'échantillons destinés à l'évaluation fonctionnelle est prévu en mars 2027 à certains clients.

La croissance des applications gourmandes en données, y compris l'IA générative, a entraîné une augmentation rapide de la demande de mémoire à haute capacité pour les systèmes informatiques. Cependant, le stockage de la plupart des données dans la DRAM pose des défis en termes de capacité, de coût et de consommation d'énergie. En tirant parti de la latence de lecture et de l'efficacité énergétique de XL-FLASH™, les nouvelles architectures système peuvent stocker les données de manière appropriée en fonction de la fréquence d'accès et des exigences de performance, en complétant la DRAM ou en remplaçant une partie de celle-ci par de la mémoire flash.

« À mesure que l'IA continue de stimuler la demande en capacités de mémoire accrues, cette approche contribuera à répondre à ces exigences croissantes tout en réduisant le coût total de possession (TCO) des serveurs d'IA, des centres de données et d'une large gamme d'autres applications », a déclaré Axel Störmann, vice-président et directeur de la technologie chez KIOXIA Europe GmbH.

KIOXIA poursuivra le développement de XL-FLASH™, tout en explorant son utilisation dans une gamme d'applications, notamment les SSD à haute IOPS et les modules d'extension de mémoire compatibles avec Compute Express Link (CXL). Grâce à ces efforts, KIOXIA vise à créer une nouvelle couche mémoire qui comble le fossé entre la DRAM et le stockage conventionnel.

###

Remarques :

1 : Comparaison de la latence de lecture basée sur des mesures effectuées sur des produits TLC BiCS FLASH™ de 1 To de 8e génération de KIOXIA et un prototype XL-FLASH™ de 3e génération. Sur la base des tests internes de KIOXIA.

2 : Comparaison de l'efficacité énergétique en lecture par unités de 512 octets, basée sur des mesures effectuées sur des produits XL-FLASH™ de 2e génération et un prototype XL-FLASH™ de 3e génération. Sur la base des tests internes de KIOXIA.

Les marques commerciales, marques de service et/ou noms de sociétés suivants, Compute Express Link, CXL, Compute Express Link Consortium, Inc., ne sont ni déposés, ni enregistrés, ni créés et/ou détenus par KIOXIA Europe GmbH ou par les sociétés affiliées du groupe KIOXIA. Toutefois, ils peuvent être déposées, enregistrés, créés et/ou détenus par des tiers dans différentes juridictions et être, de ce fait, protégés contre toute utilisation non autorisée.

Les informations contenues dans ce document, y compris les prix et les spécifications des produits, le contenu des services et les coordonnées, sont correctes à la date de l'annonce, mais sont sujettes à modification sans préavis.

À propos de KIOXIA Europe GmbH

KIOXIA Europe GmbH est la filiale européenne de KIOXIA Corporation, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de mémoires flash et de disques SSD (Solid State Drive). De l'invention de la mémoire flash NAND à la célèbre mémoire flash 3D BiCS FLASH™ d'aujourd'hui, KIOXIA continue de proposer des solutions en matière de mémoire et des services innovants qui enrichissent la vie des gens et élargissent les horizons de la société. La technologie innovante de mémoire flash 3D BiCS FLASH™ de l'entreprise façonne l'avenir du stockage dans les applications haute densité, notamment les smartphones de pointe, les PC, les systèmes automobiles, les centres de données et les systèmes d'IA générative.

Visitez notre site Web KIOXIA

Coordonnées pour la publication :

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 183, 40549 Düsseldorf, Allemagne

Tél. : +49 (0)211 368 77-0

E-mail : KIE-support@eu.kioxia.com

Coordonnées pour les demandes de nature rédactionnelle :

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH

Tél. : +49 (0) 211 36877 382

E-mail : lena.hoffmann@eu.kioxia.com

Publié par :

Birgit Schöniger, Pretzl GmbH

Tél. : +49 (0)172 617 8431

E-mail : birgit.schoeniger@pretzl.com

Web : www.pretzl.com